

トランジスタ

T-33-09 2SD855, 2SD855A

2SD855, 2SD855A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Eptaxial Planar

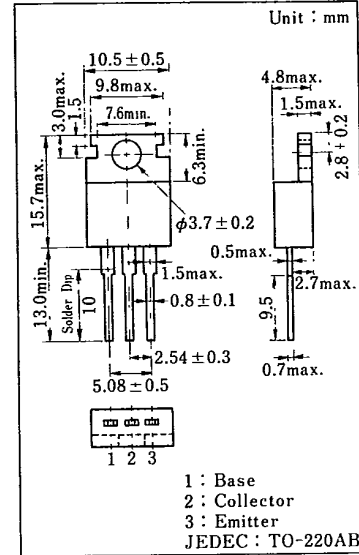
中出力電力増幅用 / Medium Power Amplifier
 2SB760, 2SB760A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
 with 2SB760, 2SB760A

■ 特徴 / Feature

- コレクタ損失 P_C が大きい。 / Large P_C

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
2SD855A		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
2SD855A		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	2	A
コレクタ電流	I_C	1	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	30	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE} = 60\text{ V}, I_B = 0$			300	μA
	I_{CES}	$V_{CE} = 80\text{ V}, I_B = 0$			200	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{CB} = 5\text{ V}, I_C = 0$			1	mA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 30\text{ mA}, I_B = 0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 0.2\text{ A}$	40		450	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	15			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 1\text{ A}, I_C = 1\text{ A}$			1.3	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 1\text{ A}, I_B = 0.125\text{ A}$			1	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 1\text{ A}, I_{B1} = -I_{B2} = 0.1\text{ A}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			1		μs

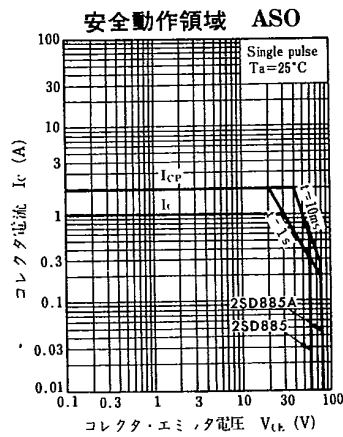
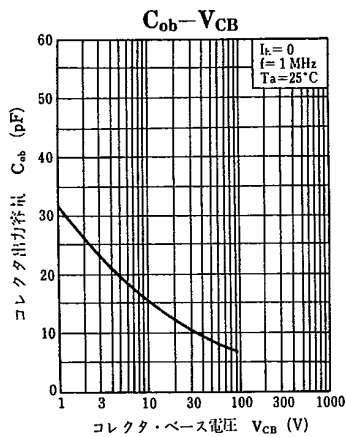
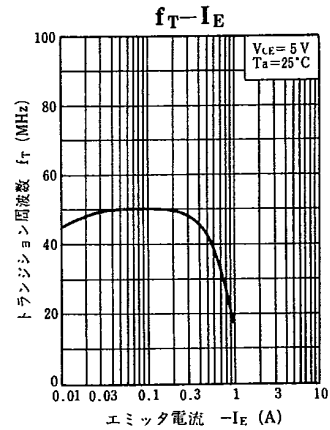
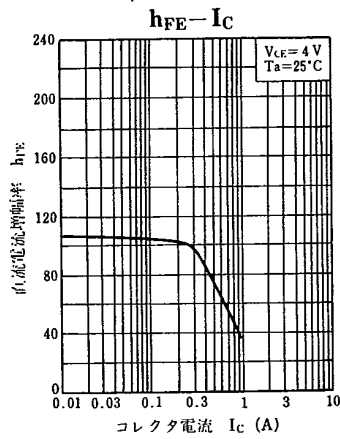
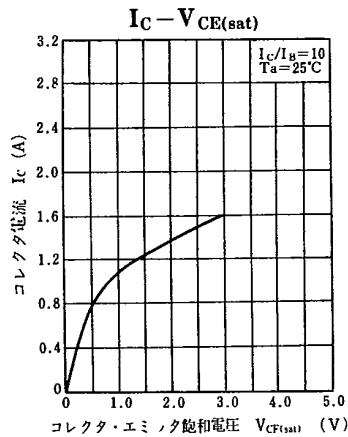
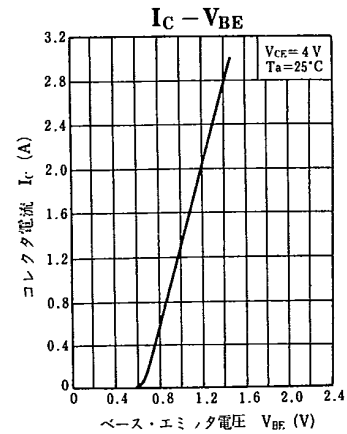
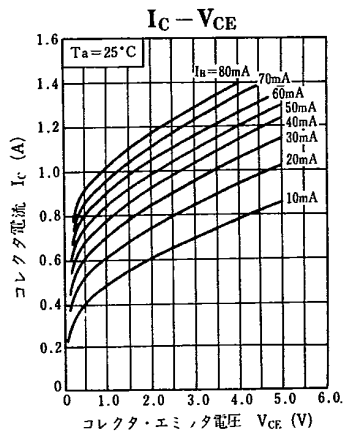
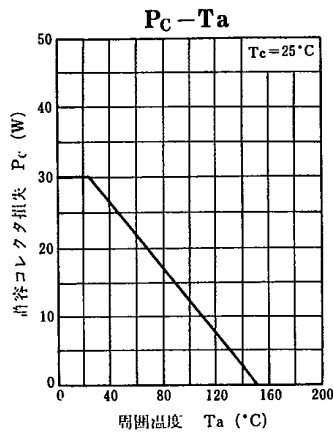
* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P	O
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250	200~450

トランジスタ

T-33-09

2SD855, 2SD855A



トランジスタ

2SD856, 2SD856A

2SD856, 2SD856A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形 / Si NPN Epitaxial Planar

低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

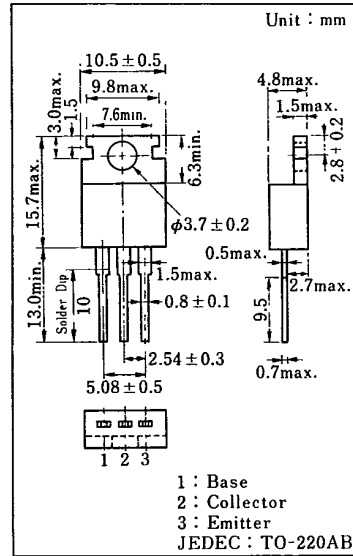
2SB761, 2SB761A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB761, 2SB761A

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きく、直線性がよい。 / High h_{FE} and good linearity
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
	2SD856A	80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
	2SD856A	80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	6	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	5	A
コレクタ電流	I_C	3	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	I_{CES}	$V_{CE}=60\text{ V}, V_{BE}=0$			200	μA
	2SD856A	$V_{CE}=80\text{ V}, V_{BE}=0$			200	
コレクタ シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=30\text{ V}, I_B=0$			300	μA
	2SD856A	$V_{CE}=40\text{ V}, I_B=0$			300	
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{ V}, I_C=0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=30\text{ mA}, I_B=0$	60			V
	2SD856A		80			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=1\text{ A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=3\text{ A}$	10			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=3\text{ A}$			1.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3\text{ A}, I_B=0.375\text{ A}$			1.2	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=1\text{ A}, I_{B1}=-I_{B2}=0.1\text{ A}$		0.5		μs
ターンオフ時間	t_{off}			3		μs

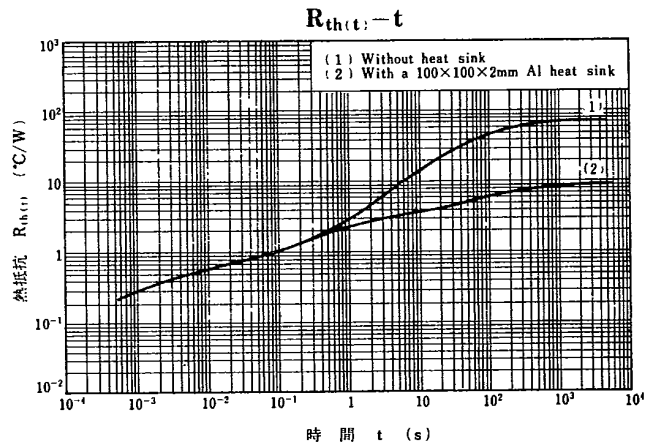
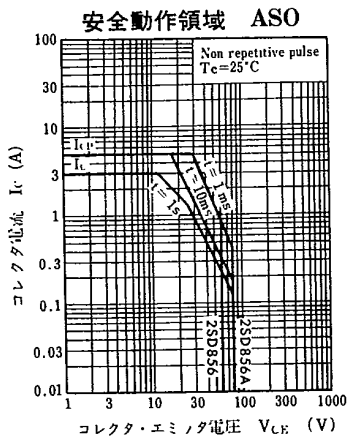
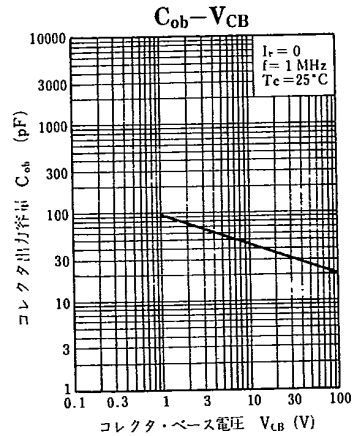
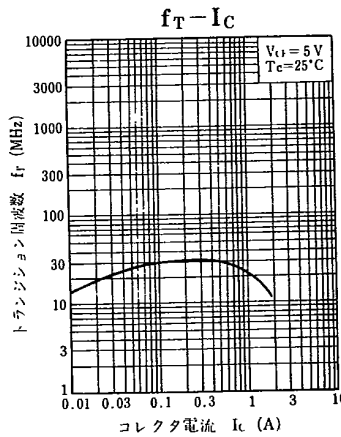
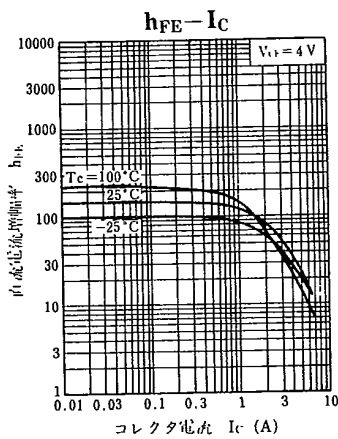
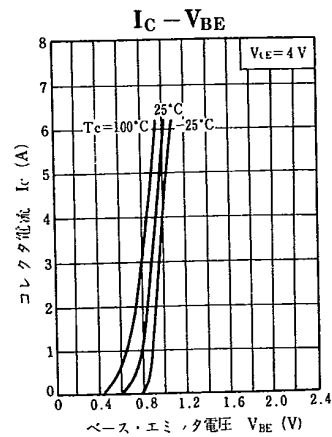
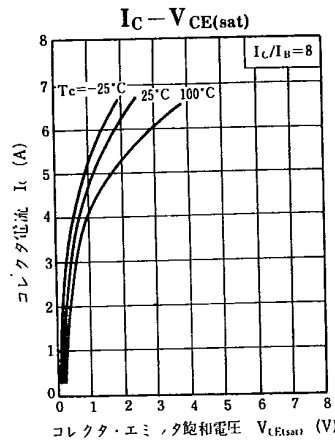
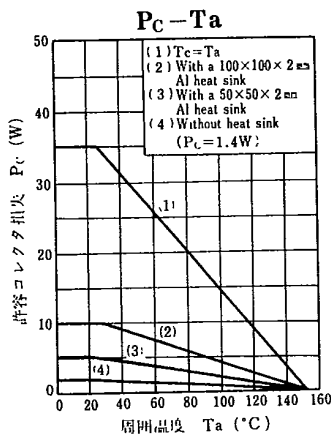
* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250

トランジスタ

T-33-11

2SD856, 2SD856A



2SD857, 2SD857A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形 / Si NPN Triple Diffused Planar

低周波電力増幅用 / AF Power Amplifier

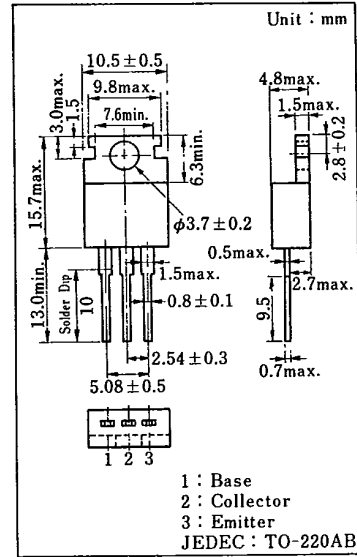
2SB762, 2SB762A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB762, 2SB762A

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が大きく、直線性がよい。 / High and good linearity of h_{FE}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。 / Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Rating ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	60	V
		80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	60	V
		80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	8	A
コレクタ電流	I_C	4	A
コレクタ損失 ($T_c=25^\circ\text{C}$)	P_C	40	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	I_{CES}	$V_{CE}=60\text{ V}, V_{BE}=0$			400	μA
		$V_{CE}=80\text{ V}, V_{BE}=0$			400	
コレクタ しゃ断電流	I_{CEO}	$V_{CE}=30\text{ V}, I_B=0$			700	μA
		$V_{CE}=60\text{ V}, I_B=0$			700	
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{ V}, I_C=0$			1	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=30\text{ mA}, I_B=0$	60			V
			80			
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=1\text{ A}$	40		250	
	h_{FE2}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=3\text{ A}$	15			
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{ V}, I_C=3\text{ A}$			2	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=4\text{ A}, I_B=0.4\text{ A}$			1.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C=4\text{ A}, I_{B1}=-I_{B2}=0.4\text{ A}$		0.2		μS
ターンオフ時間	t_{off}			1.4		μS

* h_{FE1} ランク分類 / h_{FE1} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE1}	40~90	70~150	120~250

トランジスタ

T-33-11

2SD857, 2SD857A

